



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

N° d'enregistrement national

FA 627080
FR 0215124

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
①	A, D EP 0 401 742 A (CGE) 12 décembre 1990 (1990-12-12) * abrégé; figures 1,2 *	1, 14	C03B37/014 C03B37/018
②	A WO 99 52832 A (FIBERCORE INC) 21 octobre 1999 (1999-10-21) * revendication 1; figures 1,2 *	1, 14	
③	X US 4 689 212 A (MANSFIELD R J) 25 août 1987 (1987-08-25) * abrégé; figures 1,2 *	14-16	
④	X GB 2 134 896 A (INT STD ELECTRIC CORP) 22 août 1984 (1984-08-22) * abrégé; figure 1 *	14, 18, 19	
⑤	X PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 02, 31 mars 1995 (1995-03-31) & JP 06 321552 A (FUJIKURA LTD), 22 novembre 1994 (1994-11-22) * abrégé *	14, 20	
⑥	A US 4 402 720 A (EDAHIRO T ET AL) 6 septembre 1983 (1983-09-06) * colonne 3, ligne 25 - ligne 43 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			C03B
See attached translation sheet ligne = line revendications - claims colonne = column abrege = summary/abstract			
1	Date d'achèvement de la recherche 13 août 2003	Examinateur Stroud, J	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			
T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0215124 FA 627080**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 13-08-2003

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0401742 A 12-12-1990	FR DE DE EP JP US	2647778 A1 69003175 D1 69003175 T2 0401742 A1 3028140 A 5194714 A	07-12-1990 14-10-1993 05-01-1994 12-12-1990 06-02-1991 16-03-1993
WO 9952832 A 21-10-1999	AU AU BR CA CN EP JP WO US ZA	750390 B2 3488499 A 9909569 A 2328143 A1 1332702 T 1086053 A1 2003510234 T 9952832 A1 6536240 B1 9902666 A	18-07-2002 01-11-1999 05-11-2002 21-10-1999 23-01-2002 28-03-2001 18-03-2003 21-10-1999 25-03-2003 13-10-1999
US 4689212 A 25-08-1987	CA DE EP JP	1258206 A1 245716 T1 0245716 A1 62283840 A	08-08-1989 17-03-1988 19-11-1987 09-12-1987
GB 2134896 A 22-08-1984	DE AU FR JP	3304552 A1 2425884 A 2540856 A1 59152239 A	16-08-1984 16-08-1984 17-08-1984 30-08-1984
JP 06321552 A 22-11-1994	AUCUN		
US 4402720 A 06-09-1983	JP JP JP JP DE GB GB	1373039 C 56104738 A 61038138 B 56120531 A 3037491 A1 2062615 A ,B 2129417 A ,B	07-04-1987 20-08-1981 27-08-1986 21-09-1981 09-04-1981 28-05-1981 16-05-1984

NATIONAL INSTITUTE
OF INDUSTRIAL PROPERTY

SEARCH REPORT
drawn up on the ground of the
last claims filed before the
beginning of the search

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Relevant to claim			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages				
			Technical fields Searched (Int. CL. 7)		
Date of completion of the search:		Examiner:			
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : relevant against at least one claim Or: technological background O : non-written disclosure P : intermediate document </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document based on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent or corresponding document </td> </tr> </table>				X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : relevant against at least one claim Or: technological background O : non-written disclosure P : intermediate document	T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document based on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent or corresponding document
X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : relevant against at least one claim Or: technological background O : non-written disclosure P : intermediate document	T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document based on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent or corresponding document				



(19) Europäisches Patentamt
 European Patent Office
 Office européen des brevets

(11) Numéro de publication: 0 401 742
 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 90110603.9

(51) Int. Cl. 5: C03B 37/014, C03B 37/018

(22) Date de dépôt: 05.06.90

(30) Priorité: 05.06.89 FR 8907391

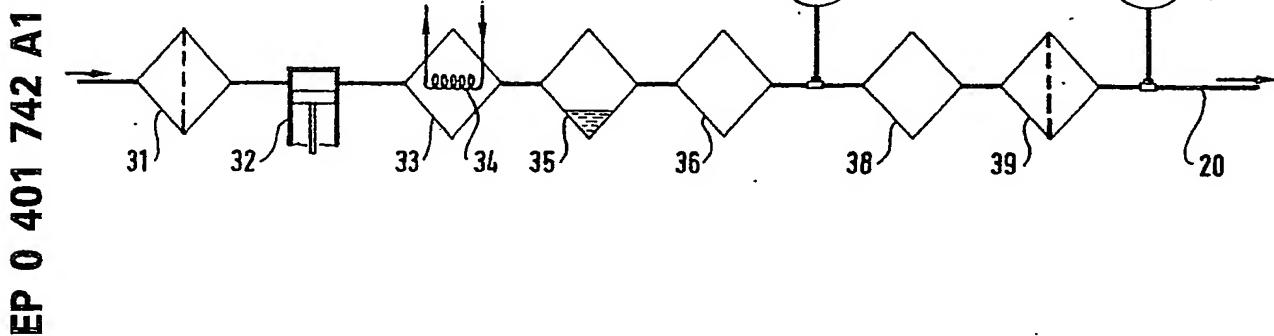
(71) Demandeur: COMPAGNIE GENERALE
 D'ELECTRICITE Société anonyme dite:
 54, rue La Boétie
 F-75382 Paris Cedex 08(FR)(43) Date de publication de la demande:
 12.12.90 Bulletin 90/50(72) Inventeur: Le Sergent, Christian
 20, rue de la Roche Garnier
 F-91460 Marcoussis(FR)(84) Etats contractants désignés:
 DE FR GB IT NL(74) Mandataire: Weinmiller, Jürgen et al
 Lennéstrasse 9 Postfach 24
 D-8133 Feldafing(DE)

(54) Procédé et dispositif de dépôt externe par plasma de silice exempté d'ions hydroxylos.

(57) Procédé et dispositif de dépôt externe par plasma sur un barreau de silice sensiblement exempté d'ions hydroxylos, éventuellement dopée en vue de modifier son indice de réfraction, par réaction sur de l'oxygène d'un composé du silicium, et éventuellement de composés dopants, en présence d'un plasma de gaz porté à très haute température par induction à l'aide d'un générateur à haute fréquence.

On maintient le barreau sur lequel est effectué le dépôt de silice dans une enceinte étanche séparée de l'atmosphère ambiante, et alimentée (20) en air atmosphérique, que l'on soumet successivement à une filtration (31), à une compression (32) et à une réfrigération (33), à une purge de l'eau condensée (35), puis à une dessiccation finale par absorption (36,38).

FIG. 3



EP 0 401 742 A1

Procédé et dispositif de dépôt externe par plasma de silice exempte d'ions hydroxyles.

L'invention concerne un procédé de dépôt externe par plasma sur un barreau de silice, éventuellement dopée en vue de modifier son indice de réfraction, sensiblement exempte d'ions hydroxyles, par réaction d'un composé de silicium, tel que SiCl₄ par exemple, et éventuellement de composés dopants, sur de l'oxygène en présence d'un plasma créé par induction à l'aide d'un générateur à haute fréquence. Elle s'étend en outre à un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Ce procédé et ce dispositif servent notamment à la fabrication de préformes destinées à être par la suite transformées par étirage en fibres optiques pour câbles de télécommunications. On sait que le coefficient d'affaiblissement linéaire de telles fibres optiques dépend étroitement de la teneur de la silice qui les constitue en ions hydroxyles, ceux-ci entraînant une certaine absorption du rayonnement dans les domaines de longueurs d'onde du rayonnement habituellement transmis par les fibres, notamment à 1,4 micron.

On peut éviter dans une très large mesure la présence d'ions hydroxyles dans une couche de silice déposée à l'intérieur d'un tube maintenu en rotation et chauffé à l'extérieur par un chalumeau en translation le long du tube, du fait que l'on peut contrôler le caractère parfaitement sec des réactifs gazeux introduits dans le tube pour amener le dépôt de silice sur sa paroi interne. Il n'en est plus de même lorsque l'on veut effectuer le dépôt de silice sur la surface externe d'un mandrin, réchauffé par l'arrivée sur sa surface d'un plasma de gaz à très haute température en même temps que des gaz réactifs devant donner naissance à la silice à déposer.

Ce dépôt peut s'effectuer soit sur toute la surface externe du mandrin, celui-ci étant en rotation autour de son axe et en translation vis-à-vis des arrivées de plasma et de gaz réactifs. Il peut s'effectuer également sur l'extrémité du mandrin, le plasma de gaz et l'injection réactifs étant alors dirigés sur cette extrémité du mandrin, en général pour obtenir un barreau de silice pure. Mais dans les deux cas l'on ne peut éviter la présence d'humidité à proximité du mandrin, et par suite la présence d'ions hydroxyles dans la silice déposée sur le mandrin, les teneurs minimales en ions hydroxyles dans la silice obtenue ne descendant pas en pratique au-dessous de quelques dizaines de parties par million.

La présente invention a pour but de fabriquer des barreaux comportant une couche externe de silice sensiblement exempte d'ions hydroxyles, ou des barreaux de silice sensiblement exempts de ces ions, susceptibles de permettre par la suite la

fabrication de fibres optiques à très faible coefficient d'affaiblissement linéaire.

Le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que l'on maintient le barreau sur lequel est effectué le dépôt de silice dans une enceinte étanche séparée de l'atmosphère ambiante et alimentée en air atmosphérique que l'on soumet successivement à une filtration, à une compression et à une réfrigération, à une purge de l'eau condensée, puis à une dessiccation finale par adsorption.

Le dispositif selon l'invention, comprenant un barreau de réception du dépôt de silice, un support assurant sa rotation et sa translation, une torche d'arrivée de gaz plasmagène, une bobine d'induction alimentée par un générateur à haute fréquence autour de l'extrémité de la torche, et une buse d'injection vers le barreau d'un mélange d'oxygène et d'un composé du silicium, et éventuellement de composés dopants, est caractérisé en ce que l'ensemble de ces organes est disposé à l'intérieur d'une enceinte étanche séparée de l'atmosphère ambiante et alimentée en air atmosphérique par un conduit muni d'au moins un filtre, un compresseur, un réfrigérant, un purgeur de l'eau condensée et un lit adsorbeur de l'humidité résiduelle.

Il est décrit ci-après, à titre d'exemples et en référence aux figures schématiques du dessin annexé, des installations de dépôt de silice sur un mandrin et une ligne de dessiccation d'air selon le procédé de l'invention.

La figure 1 représente une installation de dépôt de silice dopée sur tout le pourtour d'un mandrin de silice animé d'une rotation autour de son axe et d'une translation perpendiculairement aux arrivées du plasma et des gaz réactifs.

La figure 2 représente une installation de dépôt de silice pure sur l'extrémité d'un mandrin de silice en rotation autour de son axe et animé d'une translation lente l'éloignant des arrivées du plasma et des gaz réactifs au fur et à mesure de la croissance du dépôt.

La figure 3 représente une ligne de dessiccation d'air alimentant l'enceinte fermée entourant le mandrin, la torche à plasma et l'injecteur de gaz réactifs.

Dans la figure 1, un conduit 1 sert à l'introduction de tétrachlorure de silicium dans un évaporateur, maintenu à une température aussi constante que possible. Le tétrachlorure de silicium vaporisé passe dans un réchauffeur 3, puis dans un contrôleur de débit 4 et un conduit 4A. Simultanément, un gaz fluoré tel que du dichlorodifluorométhane, issu d'une bouteille 5, se rend par un contrôleur de pression 6 et un contrôleur de débit 7 à un conduit 10 rejoignant le conduit 4A d'arrivée de tétrachloru-

re de silicium gazeux, de même qu'un courant d'oxygène arrivant par un conduit 8 et un contrôleur de débit 9. Les gaz réactifs sont réchauffés dans un réchauffeur 11, puis se rendent par le conduit 12 à l'injecteur 12A d'amenée des gaz réactifs au contact du plasma et du mandrin à recouvrir d'une couche de silice dopée au fluor.

Par ailleurs, un gaz plasmagène tel que de l'oxygène, de l'azote ou de l'argon, est introduit dans une torche 13, dont l'extrémité est entouré par un bobinage 14 alimenté en courant à haute fréquence par le générateur 15. Le plasma de gaz ionisé à haute température forme un dard 16 débouchant sur le pourtour du mandrin 17. Ce dernier tourne autour de son axe et est entraîné par un support 18 dans une translation régulière dans une direction perpendiculaire aux arrivées de plasma et gaz réactifs. Le mandrin, la torche et l'injecteur de gaz réactifs sont disposés dans une enceinte fermée 19 reliée d'une part à une tubulure d'arrivée d'air sec 20, d'autre part à un conduit 21 d'évacuation de gaz résiduaires, relié à une installation d'épuration des gaz évacués.

L'installation de dépôt de silice pure sur l'extrémité d'un mandrin de la figure 2 est analogue dans une large mesure à celle de la figure 1. L'alimentation en tétrachlorure de silicium à partir de l'évaporateur 2 est similaire. Le dépôt devant être de la silice pure, le seul autre gaz réactif est de l'oxygène arrivant par le conduit 8, le contrôleur de débit 9 et le conduit 10. Les gaz réactifs réchauffés dans le réchauffeur 11, se rendent par le conduit 12 à l'injecteur 12A.

Par ailleurs, un gaz plasmagène est introduit dans la torche à plasma 13 entourée par le bobinage 14 alimenté en courant à haute fréquence par le générateur 15. Il se forme à la sortie de la torche 13 un dard de plasma à très haute température 16 débouchant sur l'extrémité du mandrin 12, ce dernier, tournant autour de son axe et étant entraîné par son support 23 dans une translation lente l'éloignant progressivement de la torche et de l'injecteur de gaz réactifs au fur et à mesure du dépôt de silice sur l'extrémité du mandrin.

Comme précédemment, le mandrin, la torche à plasma et l'injecteur sont à l'intérieur d'une enceinte fermée 19, alimentée en air desséché par la tubulure 20 et rejetant le gaz résiduaire vers une installation de traitement par un conduit 21.

Dans la ligne de dessiccation d'air représentée en figure 3, l'air atmosphérique subit une première épuration, destinée à en éliminer les poussières, les vapeurs organiques (huiles) et chlorhydriques, sur un filtre à charbon actif 31. Il passe dans un compresseur 32, puis dans un réfrigérant à eau 33, où il est refroidi par contact indirect avec un serpentin de circulation d'eau froide 34. Il se rend dans un purgeur 35 d'élimination de l'eau condensée,

sé, puis dans un adsorbeur 36 d'élimination de l'humidité, constitué par exemple d'une zéolithe. Il est relié en aval de cet adsorbeur à un réservoir tampon 37, puis passe dans un adsorbeur final 38 et un filtre final 39 à un réservoir 40 d'alimentation du conduit 20 d'amenée de l'air desséché à la tubulure d'introduction dans l'enceinte fermée entourant le mandrin, la torche à plasma et l'injecteur de réactifs.

Une telle ligne de traitement permet d'obtenir de l'air de teneur résiduaire en vapeur d'eau ne dépassant pas une partie par million en volume. On peut réaliser de ce fait des dépôts de silice, dopée ou non, de teneur en ions hydroxyles inférieure à une partie par million, et typiquement de l'ordre de 0,1 partie par million, utilisables pour la fabrication de fibres optiques de coefficients d'affaiblissement linéaire très faibles.

20

Revendications

1/ Procédé de dépôt externe par plasma sur un barreau (17, 22) de silice sensiblement exempte d'ions hydroxyles, éventuellement dopée en vue de modifier son indice de réfraction, par réaction sur de l'oxygène d'un composé du silicium, et éventuellement de composés dopants, en présence d'un plasma de gaz porté à très haute température (16) par induction à l'aide d'un générateur à haute fréquence (15),

caractérisé en ce que l'on maintient le barreau sur lequel est effectué le dépôt de silice dans une enceinte étanche (19) séparée de l'atmosphère ambiante, et alimentée (20) en air atmosphérique que l'on soumet successivement à une filtration (31), à une compression (32) et à une réfrigération (33), à une purge de l'eau condensée (35), puis à une dessiccation finale par adsorption (36, 38).

2/ Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, comprenant un barreau de réception du dépôt de silice (17, 22), un support (18, 23) assurant sa rotation et sa translation, une torche (13) d'arrivée de gaz plasmagène, une bobine d'induction (14) alimentée par un générateur à haute fréquence (15) autour de l'extrémité de la torche, et une buse d'injection vers le barreau d'un mélange d'oxygène et d'un composé du silicium, et éventuellement de composés dopants, caractérisé en ce que l'ensemble de ces organes est disposé à l'intérieur d'une enceinte étanche (19) séparée de l'atmosphère et alimentée en air atmosphérique par un conduit muni d'au moins un filtre (31, 39), un compresseur (32), un réfrigérant (33), un purgeur de l'eau condensé (35) et au moins un lit adsorbeur de l'humidité résiduelle (36, 38).

FIG.1

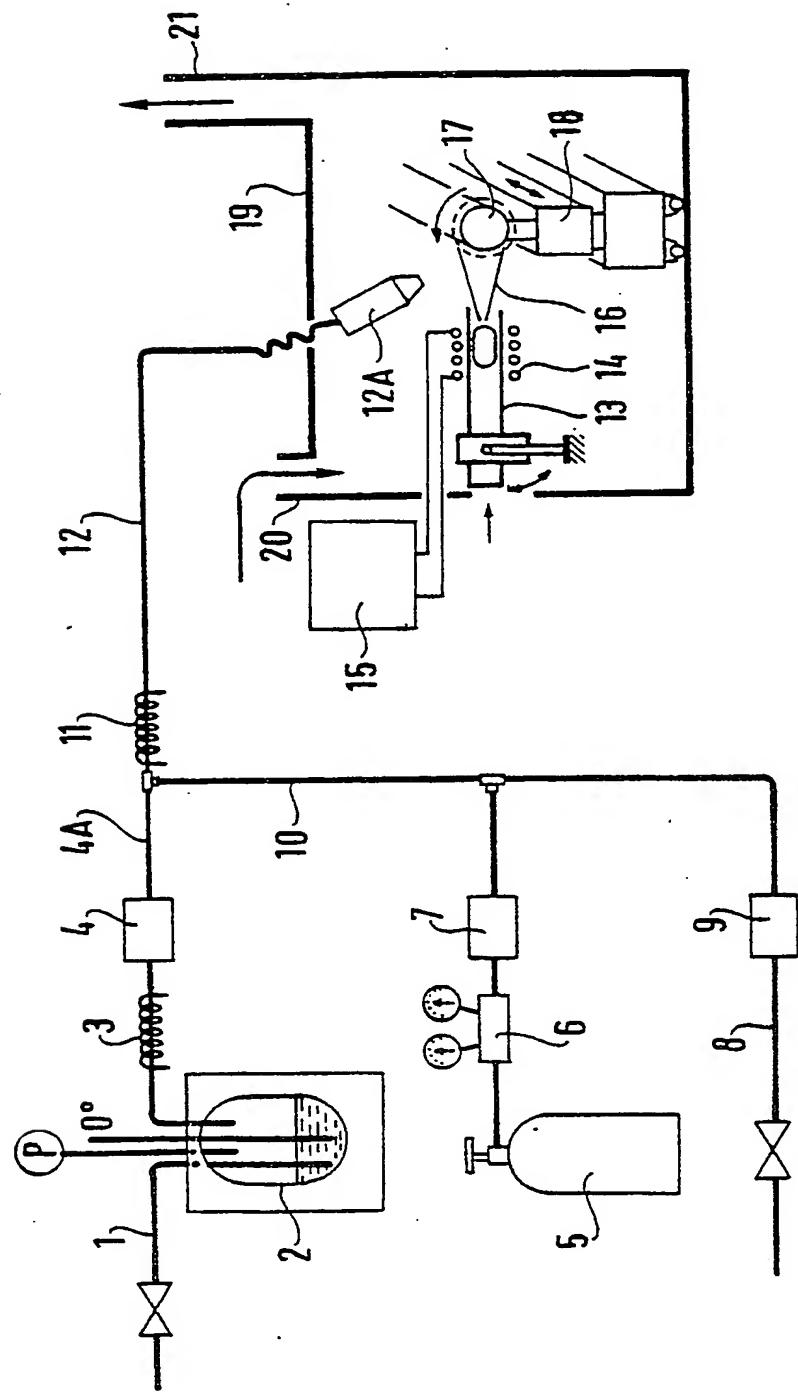


FIG. 2

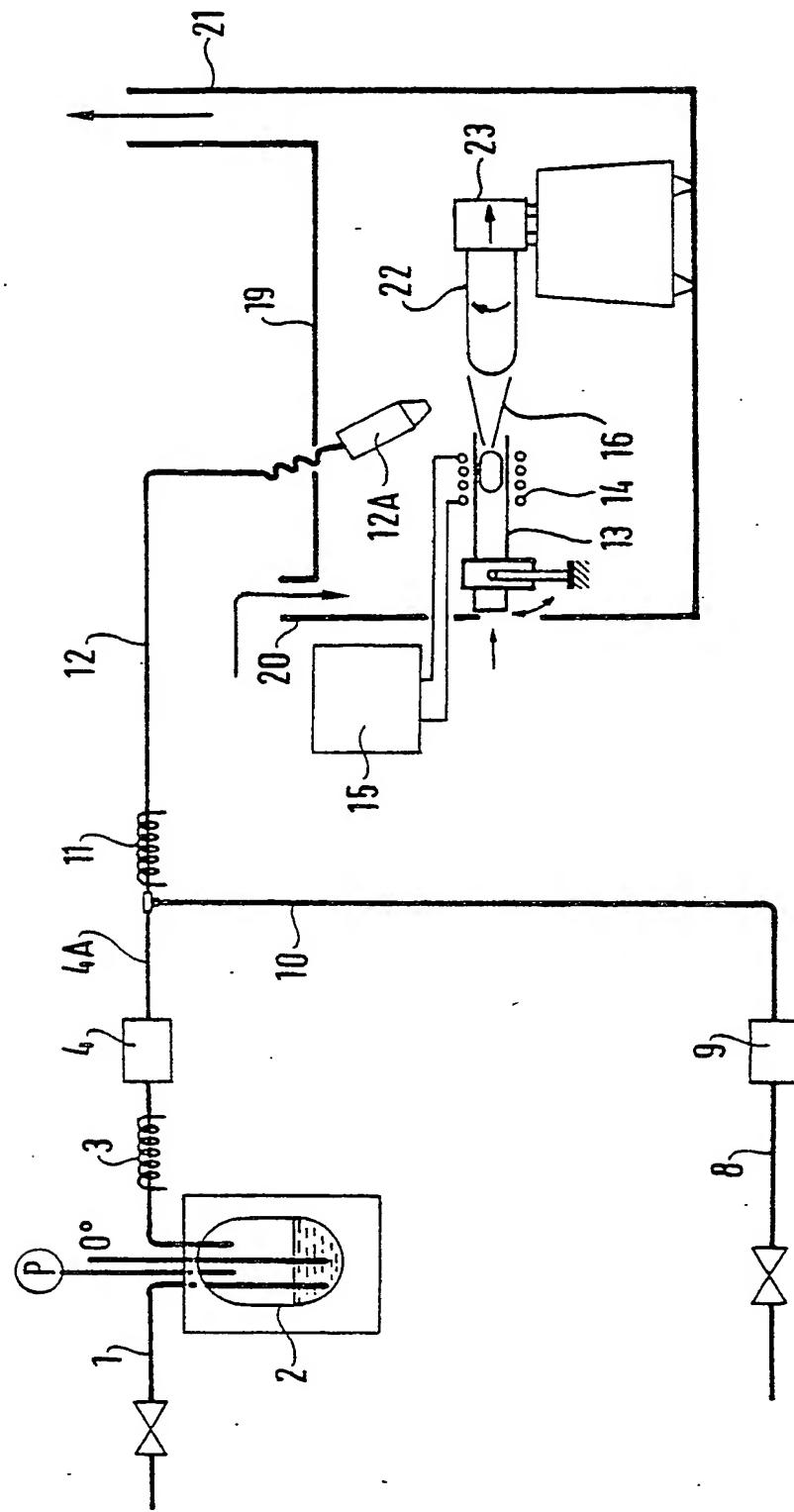
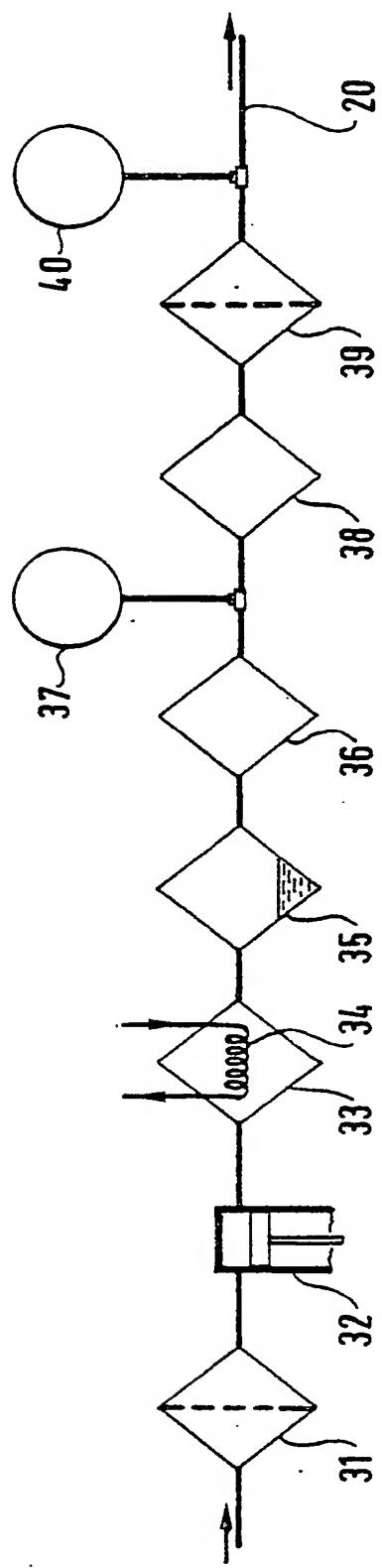


FIG. 3





Office européen des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 90 11 0603

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.S)
A	EP-A-0 054 495 (QUARTZ et SILICE) * En entier * ---	1	C 03 B 37/014 C 03 B 37/018
A	DE-A-3 404 119 (MERCK PATENT GmbH) * Revendications 1,3,4 *---	1,2	
A	EP-A-0 231 022 (SUMITOMO ELECTRIC IND. LTD) * Pages 9,10 *---	1,2	
A	DE-A-3 420 790 (SIEMENS AG) * Revendications 1,8 *---	1	
A	US-A-4 162 908 (K. RAU et al.) * Figures 1,2 *---	1	
A	EP-A-0 141 365 (WACKER-CHEMITRONIC) * Abrégé *---		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 71 (C-334)[2128], 20 mars 1986; & JP-A-60 210 540 (SUMITOMO DENKI KOGYO K.K.) 23-10-1985 -----	1,2	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.S)
			C 03 B 37/014 C 03 B 37/018
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la recherche	Examinateur	
LA HAYE	22-08-1990	STROUD J.G.	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul	T : théorie ou principe à la base de l'invention		
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie	E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date		
A : arrière-plan technologique	D : cité dans la demande		
O : divulgation non-écrite	L : cité pour d'autres raisons		
P : document intercalaire	& : membre de la même famille, document correspondant		